

Pチャンネル型MOS-FET(ゲート保護DI有り品)

小型PKG (SC-59) Pch MOS-FET大電流製品群を開発中!

INJxxxxxC1 series

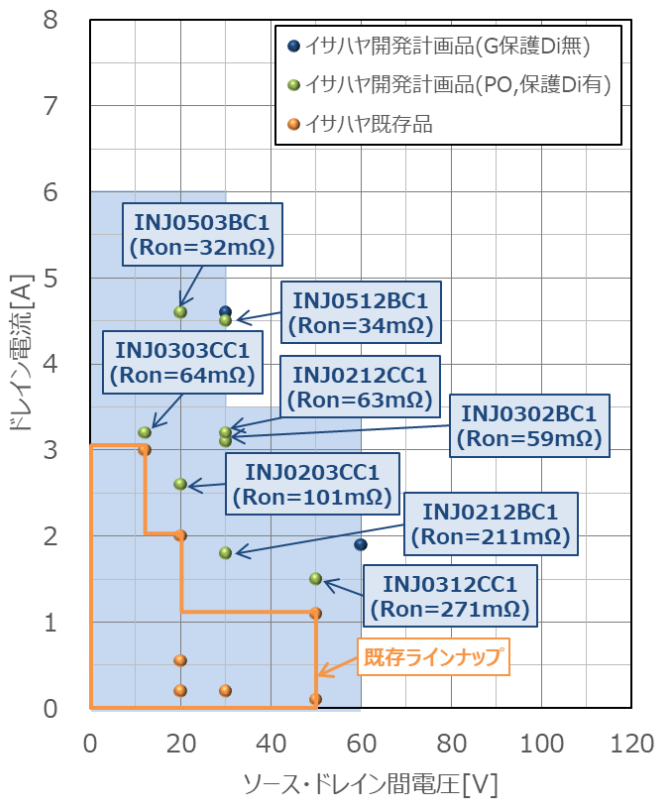
※車載対応品も順次展開予定です。

開発中

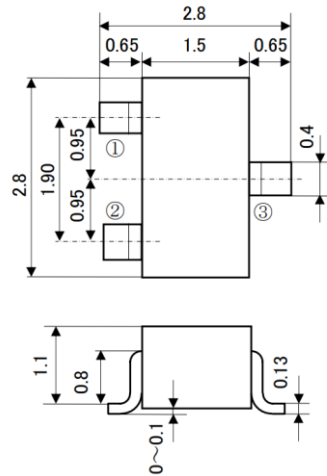
□概要

当社の小型PKG(SC-59) Pチャンネル型MOS-FETラインナップに当社では今までになかった大電流で使用できる製品を新たに追加いたしました。追加開発品種においては、下記特性早見表および互換表をご確認ください。

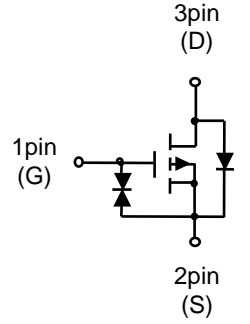
□耐圧-電流マップ



□外形図 単位(mm)



□等価回路



※ゲート保護DI有り

□互換表

形名	VDSS [V]	ID [A]	RDS (on) [mΩ]	極性	リリース時期			他社相当品	
					ES	CS	MP	T社	R社
INJ0303CC1	12	3.2	64	Pch	NOW	TBD	TBD	---	RQ5A020ZP
INJ0503BC1	20	4.6	32*	Pch	NOW	'23/3	TBD	SSM3J331R	RTR030P02
INJ0512BC1	30	4.5	34	Pch	NOW	TBD	TBD	SSM3J340R	RQ5E040RP
INJ0302BC1	30	3.1	59*	Pch	NOW	'23/7	TBD	SSM3J14T	RQ5E025SP
INJ0203CC1	20	2.6	101	Pch	NOW	TBD	TBD	SSM3J352F	RQ5C020TP
INJ0212BC1	30	1.8	211	Pch	NOW	TBD	TBD	SSM3J353F	RQ5E015RP
INJ0212CC1	30	3.2	63	Pch	NOW	TBD	TBD	SSM3J14T	RQ5E025SP
INJ0312CC1	50	1.5	271	Pch	'23/2	TBD	TBD	---	---

※RDS(on)は、標準値を記載しております。
 ※RDS(on)の測定条件は VGS=10V(*は4.5V), ID=(各機種に記載されたID) となります。
 ※熱許容損失(PD)は基板実装時 0.9W となります。